



高温整流二极管芯片产品说明书

一、芯片特点

- 1、采用沟槽氮化硅玻璃烧结工艺。
- 2、正向压降低，功耗小。
- 3、高温 200℃ 下反向漏电流小。
- 4、浪涌电流能力强。
- 5、芯片双面镍钛银金属化，牢固度强。
- 6、与正向芯片配合易于组装成三相桥电路。



二、主要用途：用于制作各种高温整流二极管，用于各种电器、电机及电子电路中整流用。

三、主要电特性：

型号	最大正向电流 I_F (A)	最大反向重复峰值电压 V_{RRM} (V)	最大浪涌电流 I_{FSM} (A)	最大峰值电压 V_{FM} (V)	最大反向漏电流		少子寿命 τ (s)	工作结温 T_{jm} (°C)	备注
					I_{R1} (μ A) (25°C)	I_{R2} (mA) (200°C)			
Φ6 正向芯片	10	>600	200	≤ 1.1	<5	<2	<30	-55~ 200	芯片详细特性、外形尺寸以各芯片的规格书为准。
Φ6 反向芯片	10	>600	200	≤ 1.1	<5	<2	<30		
Φ9 正向芯片	40	>600	800	≤ 1.2	<10	<20	<30		
Φ9 反向芯片	40	>600	800	≤ 1.2	<10	<2	<30		
Φ11 正向芯片	60	>1200	900	≤ 1.2	<20	<3	<40		
Φ11 反向芯片	60	>1200	900	≤ 1.2	<20	<3	<40		
Φ12.4 正向芯片	70	>1000	1700	≤ 1.2	<20	<3	<50		
Φ12.4 反向芯片	70	>1000	1700	≤ 1.2	<20	<3	<50		
Φ15.5 正向芯片	150	>1600	2200	≤ 1.2	<20	<4	<50		
Φ15.5 反向芯片	150	>1600	2200	≤ 1.2	<20	<4	<50		

四、使用注意事项：

- 1、芯片从蓝膜上取下时，应用电热吹风对蓝膜加热后取下芯片。
- 2、建议用真空吸笔拿取芯片。
- 3、工作时应戴好口罩、静电手指套等防护用品。
- 4、严禁用手直接接触芯片。
- 5、蓝膜一旦揭掉，必须将本批芯片全部用完，防止氧化。



高温旋转整流二极管芯片产品说明书

一、芯片特点

- 1、采用沟槽氮化硅玻璃烧结工艺。
- 2、正向压降低，功耗小。
- 3、高温 200℃ 下反向漏电流小。
- 4、浪涌电流能力强。
- 5、反向恢复时间短，工作频率高。
- 6、芯片双面镍钛银金属化，牢固度强。
- 7、与正向芯片配合易于组装成三相桥电路。



二、主要用途：用于制作各种高温整流二极管，用于各种电器、电机及电子电路中整流用。

三、主要电特性：

型号	最大正向电流 I_F (A)	最大反向重复峰值电压 V_{RRM} (V)	最大浪涌电流 I_{FSM} (A)	最大峰值电压 V_{FM} (V)	最大反向漏电流		反向恢复时间 (ns)	工作结温 T_{jm} (°C)	备注
					I_{R1} (μ A) (25°C)	I_{R2} (mA) (200°C)			
Φ6 反向芯片	10	>800	200	≤ 1.4	<5	<3	<300	-55~ 200	芯片详细特性、外形尺寸以各芯片的规格书为准。
Φ9 反向芯片	40	>800	800	≤ 1.4	<10	<3	<300		
Φ11 反向芯片	60	>800	900	≤ 1.4	<20	<3	<300		
Φ12.4 反向芯片	70	>800	1700	≤ 1.6	<20	<4	<500		
Φ15.5 反向芯片	150	>800	2200	≤ 1.6	<20	<4	<500		

四、使用注意事项：

- 1、芯片从蓝膜上取下时，应用电热吹风对蓝膜加热后取下芯片。
- 2、建议用真空吸笔拿取芯片。
- 3、工作时应戴好口罩、静电手指套等防护用品。
- 4、严禁用手直接接触芯片。
- 5、蓝膜一旦揭掉，必须将本批芯片全部用完，防止氧化。